

数ナノメートル領域では 50at.%にも達する局所的な高濃度の炭素固溶が実現し、この最表面での過剰炭素がグラフェン生成に関与していることを世界で初めて見出した点が評価できる。これは、バルク材料としては炭素非固溶とされる Ga、さらには、同様に炭素非固溶である銅を用いたグラフェン合成についても、金属触媒界面での局所的な高濃度炭素の存在がグラフェンを生成へのドライビングフォースになっていると理解でき、触媒化学、ならびに材料工学上で価値のある知見であるとともに、今後の実用化技術としてもその進展が期待できる。さらに、論文著者らは、これらの触媒反応機構を応用して、 SiO_2 酸化膜上の炭素膜をグラフェン化して FET 動作を実証した。また、直径数ナノメートルと極めて細い直鎖状アミロイド蛋白線維を用いて、これをサファイヤ基板上で炭素化し、Ga による触媒反応によってグラフェンナノリボンの合成を実証した。得られたグラフェンナノリボンはラマンスペクトルの評価から、1～2 層のグラフェンであり、欠陥も少ないことを示した。また合成したグラフェンナノリボンは PMMA レジストを用いて転写可能であることを実証した。従来のトップダウン型のナノ加工技術を用いても、数ナノメートルのグラフェンナノリボンを加工することは非常に困難である。自然界に存在するアミロイド線維を用いて、この加工限界を超えることができる点を実証し得た点が評価できる。

平成 25 年 2 月 20 日、数理物質科学研究科学学位論文審査委員会において審査委員の全員出席のもと、著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員全員によって、合格と判定された。

上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。